

高频低噪声 NPN 晶体管

描述:

硅外延 NPN 晶体管

应用:

高频低噪声放大, 用于 VHF, UHF 和 CATV

工作条件(T=25℃):

参数	符合	极值	单位
BC 击穿电压	V_{CBO}	20	V
EC 击穿电压	V_{CEO}	12	V
EB 击穿电压	V_{EBO}	3	V
集电极电流	I_C	200	mA
功耗	P_C	0.5	W
结温度	T_j	150	℃
存储温度	T_{stg}	-65-+150	℃

电学特性 (T=25℃)

参数	符合	最小	典型	最大	单位	测试条件
BC 击穿电压	BV_{CBO}	20			V	$I_C=10\mu A$
EC 击穿电压	BV_{CEO}	12			V	$I_C=1mA$
EB 击穿电压	BV_{EBO}	3			V	$I_E=10\mu A$
集电极关断电流	I_{CBO}			1	μA	$V_{CB}=10V$
发射极关断电流	I_{EBO}			1	μA	$V_{EB}=1V$
直流增益	h_{FE}	50	120	300		$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
频率	f_T		5		GHz	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
输出电容	C_{ob}		0.65	1.0	p F	$V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz$
功率增益	$ S_{21e} ^2$		9.5		db	$V_{CE}=10V, I_E=20mA, f=1GHz$
噪声因子	NF		1.1		db	$V_{CE}=10V, I_C=7mA, f=1GHz$
噪声因子	NF		1.8	3.0	db	$V_{CE}=10V, I_C=40mA, f=1GMHz$

封装形式:

TO-92

